# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002084024 A

(43) Date of publication of application: 22.03.02

(51) Int. Cl

H01S 3/10

(21) Application number: 2000271921

(22) Date of filing: 07.09.00

(71) Applicant:

**NEC ENG LTD** 

(72) Inventor:

YAMAGISHI MASANAO

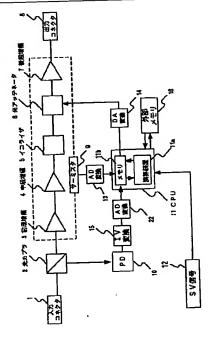
# (54) OPTICAL AMPLIFIER

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical amplifier for a long-wavelength band (1,580 to 1,610 nm), which can be actualized with simple constitution.

SOLUTION: This optical amplifier comprises an optical coupler 2, stages of amplifiers 3, 4, and 7, an equalizer 5, a variable optical attenuator 6, a temperature detecting element such as a thermistor 9, a photodiode(PD) 10, an AD converter 13, an arithmetic unit (CPU) 11, and an external memory 16 between input and output ends. The control signal of the optical attenuator 6 is generated by previously storing an external memory 16 with a 'data table' or 'calculation expression' according to parameters such as input light intensity by the PD 10, and the temperature and wavelength number information (SV signal 12) of an EDF 21 constituting the optical amplifiers 3, 4, and 7 detected by the thermistor and reading it out by the CPU

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-84024 (P2002-84024A)

(43)公開日 平成14年3月22日(2002.3.22)

(51) Int.Cl.7 H01S 3/10 識別記号

FΙ H01S 3/10

テーマコート\*(参考) Z 5F072

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧2000-271921(P2000-271921)

(22)出願日

平成12年9月7日(2000.9.7)

(71)出願人 000232047

日本電気エンジニアリング株式会社

東京都港区芝浦三丁目18番21号

(72) 発明者 山岸 正尚

東京都港区芝浦三丁目18番21号 日本電気

エンジニアリング株式会社内

(74)代理人 100081710

升理士 福山 正博

Fターム(参考) 5F072 AB09 AK06 HH02 JJ05 MM01

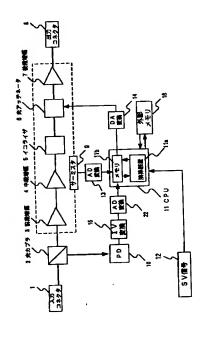
RRO1 YY17

## (54) 【発明の名称】 光増幅器

#### (57)【要約】

【課題】簡単な構成により実現可能な長波長帯(158 0~1610nm) 用の光増幅器を提供する。

【解決手段】入出力端間に光カプラ2、複数段の増幅器 3、4、7、イコライザ5、可変光アッテネータ6、サ ーミスタ9等の温度検出素子、フォトダイオード(P D) 10、AD変換器13、演算装置 (CPU) 11お よび外部メモリ16により構成される。光アッテネータ 6の制御信号は、PD10による入力光強度、サーミス タ9により検出される増幅器3、4、7を構成するED F21の温度および波長数情報(SV信号12)等のパ ラメータに基づき、予め「データテーブル」又は「計算 式」を外部メモリ16に記憶し、これをCPU11によ り読み出して生成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】入出力端間に1段以上のエルビウムドープ ドファイバ(EDF)を使用する増幅器および制御信号 により減衰度が可変する光アッテネータを含む光波長多 重通信用の光増幅器において、

信号光の光強度を測定するための光カプラおよびフォト ダイオード(PD)と、前記EDFの温度を測定する温 度検出素子と、前記PDおよび前記温度検出素子の検出 信号をデジタル変換するアナログ・デジタル(AD)変 換器と、該AD変換器から得る前記入力光強度および前 記EDF温度の2種類のパラメータに基づき前記光アッ テネータの制御信号を生成する演算装置(CPU)とを 備えることを特徴とする光増幅器。

【請求項2】前記CPUには、波長数情報もパラメータ として外部から入力されることを特徴とする請求項1に 記載の光増幅器。

【請求項3】前記光アッテネータは、複数段の前記増幅 器間に配置することを特徴とする請求項1又は2に記載 の光増幅器。

【請求項4】前記光アッテネータの前段に配置され、波 長に対する光出力を平坦にするイコライザを備えること を特徴とする請求項1、2又は3に記載の光増幅器。

【請求項5】前記パラメータと前記光アッテネータの減 衰量の関係を記述したデータテーブルを予め記憶するメ モリを設け、前記データテーブルを前記CPUが読み出 すことを特徴とする請求項1、2、3又は4に記載の光 增幅器。

【請求項6】前記パラメータから前記光アッテネータの 制御信号を決定する計算式を予めプログラミングし、前 記CPUによりリアルタイムに計算することを特徴とす 30 る請求項1、2、3又は4に記載の光増幅器。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光増幅器、特に光通 信に用いられる長波長帯用(1580~1610nm) 光増幅器に関する。

#### [0002]

【従来の技術】伝送容量が大きいこと、外部電磁界の影 響を受けないこと、信号の減衰が少ないこと、伝送媒体 が軽量であること等の多くの利点により、通信の多くは 40 従来の電気通信から光ファイバーを使用する光通信に置 換されている。また、オフィス内および車内のLANシ ステム等にも、上述した利点の1つ又は複数の利点によ り光通信が採用されつつある。

【0003】斯かる光ファイバーを伝送媒体として使用 する光通信では、長距離伝送により減衰する信号を、再 度所定レベルにするため又は複数の伝走路を経由してく る信号の振幅調整のため等に光増幅器を使用する。特に 波長分割多重(WDM)方式等の光伝送システム又は光 波長多重通信に使用する従来の光増幅器は、例えば特開 50 みならず、EDFを変更(又は交換)した場合にはパラ

平10-335722号公報の「光増幅器」又は特開平 6-5958号公報の「光ファイバ増幅装置」等に開示 されている。

【0004】従来の光通信では、信号光の波長として1 550nm帯の光を使用している。この波長帯では、増 幅器に含まれるEDF(エルビウムドープドファイバ) の温度特性によって増幅率が変わる。このため、増幅器 の出力光強度を一定にするためのALC(自動レベル制 御) 回路により増幅率を調整する。そして、EDFに入 射している励起光の強度を変化させて出力光強度を一定 に維持している。しかし、このまま増幅率のみを変化さ せると波長多重通信では長波長側と短波長側の光強度が 一定ではなくなる、即ち出力光の平坦度が崩れてしま う。出力光の平坦度が崩れるという現象は、例えば図5 に示す波長対出力光特性から図6に示す特性の如く、波 長による光強度が相違してしまうことを指す。そこで、 光アッテネータ(減衰器)をEDF間に接続して減衰量 を変化させることにより、光増幅器全体の増幅率を変化 させることなく出力光の光強度を一定に維持することが できる。その結果、光出力平坦度を崩すことがなくな り、波長多重伝送を効率良く行うことが可能になる。 【0005】光アッテネータの制御方法として、EDF

の温度情報を得るために、EDF周辺に温度によって出 力電圧値が変化するサーミスタを配置する。 そして、 温 度変化に対するサーミスタ出力電圧変化をオペアンプ (演算増幅器) に入力させて、電圧変化量を零とするよ うに光アッテネータの減衰量を変化させる帰還ループを 形成し、入力光の変動に拘らず最適の光出力平坦度を得 ている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来 技術は、次の如き解決するべき課題を有している。第1 に、従来技術では波長1550nm帯の信号光を使用し ていたが、1580nmから1610nm付近の長波長 帯信号光を光アンプで増幅する場合には、EDF温度の みで光アッテネータを制御し出力光平坦度を最適にしよ うとしても、光増幅器への入力光強度の変化時に出力光 平坦度が最適にならないという問題がある。長波長帯光 増幅器では、EDF温度の他に信号光の平坦度が変化す る原因である光増幅器への入力光強度についても同時に モニタする必要がある。そのため、光アッテネータの減 衰率を、これら2つのモニタ値により制御する必要があ るためである。

【0007】第2に、従来技術ではEDF温度および入 力光強度2つのモニタ値を演算する必要があり、更にこ の他にも個体ばらつきのあるEDF特性のパラメータも 加味して光アッテネータ減衰量を決定する必要がある。 これら複数の変数データを使用する場合には、アナログ 回路で制御する従来の方法では回路規模が複雑になるの

メータも変更になるため、最悪の場合、部品変更等を行 わなければならず、調整にも大変な労力を要することに なる。

#### [0008]

【発明の目的】従って、本発明の目的は、光増幅器の出 力光強度の波長平坦度を一定に維持するため、構成を簡 易化すると共に、操作性、信頼性および生産性を改善す る光増幅器を提供することである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明の光増幅器は、入 出力間に1段以上のエルビウムドープドファイバ(ED F) を使用する増幅器および制御信号により減衰度が可 変する光アッテネータを含む光波長多重通信用の光増幅 器であり、光信号の光強度を測定するための光カプラお よびフォトダイオード(PD)と、EDFの温度を測定 する温度検出素子(サーミスタ)と、PDおよび温度検 出素子の検出信号をデジタル変換するアナログ・デジタ ル (AD)変換器と、このAD変換器から得る光入力強 度およびEDF温度の2種類のパラメータに基づき光ア ッテネータの制御信号生成する演算装置(CPU)とを 備える。

【0010】また、本発明の光増幅器の好適実施形態に よると、上述したパラメータとして波長数情報が加えら れる。光アッテネータは、複数段の増幅器間に配置され る。また、光アッテネータの前段に配置され、波長に対 する光出力を平坦にするイコライザを備える。上述した パラメータと光アッテネータの減衰量の関係を記述した データテーブルを予め記憶するメモリを設け、このデー タテーブルをCPUが読み出す。また、上述したパラメ ータから光アッテネータの制御信号を決定する計算式を 予めプログラミングし、CPUによりリアルタイムに計 算する。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明による光増幅器の好 適実施形態の構成および動作を、添付図を参照して詳細 に説明する。

【0012】先ず、図1は、本発明による光増幅器の好 適実施形態の構成を示すブロック図である。この光増幅 器は、入力コネクタ1、光力プラ(結合器)2、前段増 幅器3、中段増幅器4、イコライザ5、光アッテネータ 6、後段増幅器7、出力コネクタ8、サーミスタ9、フ ォトダイオード (以下、PDという) 10、SV信号1 2が入力される演算装置 (CPU) 11、AD (アナロ グ・デジタル)変換器13、DA(デジタル・アナロ グ)変換器14、IV(電流一電圧)変換器15および 外部メモリ16により構成される。また、CPU11 は、演算装置11aとメモリ11bにより構成される。 【0013】次に、図1の光増幅器を構成する各素子の 機能等を説明する。入力コネクタ1および出力コネクタ

コネクタである。光カプラ2は、この光増幅器に入力さ れた波長多重信号光を分岐する。 PD10は、入力光の 光強度を測定し、電流値として出力する。前段増幅器3 および中段増幅器4は、それぞれ入力された信号光を増 幅する。イコライザ5は、平坦度を出すため一定でない 各波長の光パワーに逆特性を与え平坦にする。光アッテ ネータ6は、印加される駆動電圧値により透過特性が変 化する可変光減衰器である。後段増幅器7は、光アッテ ネータ6を通過してきた光を増幅する。

【0014】図2は、前段増幅器3、中段増幅器4およ び後段増幅器7内部の構成図である。これら増幅器3、 4 および7は、光カプラ17、EDF21、レーザダイ オード(以下、LDという)18、入力コネクタ19お よび出力コネクタ20を含んでいる。

【0015】DEF21は、信号光を増幅する。サーミ スタ9は、EDF21の周囲温度を測定し、その温度を アナログ電圧値として出力する。 IV変換器15は、P D10から出力された電流値を対応する電圧値に変換す る。AD変換器13と22は、それぞれの入力信号がア ナログ電圧であるため、デジタル値に変換する。SV信 号12は、入力されている信号光が波長多重伝送である ため、信号光に含まれる波長の数を外部からデジタル値 として伝えている。CPU11は、EDF温度、入力光 強度および波長数の3種類の情報から、出力光の平坦度 が最適になる光アッテネータ6の制御又は駆動電圧を決 定する。外部メモリ16は、「データテーブル」又は

「計算式」等のCPU11が参照するための情報を記憶 しておく。DA変換器14は、CPU11が出力するデ ジタル値を対応するアナログ電圧値に変換し、出力光強 度の波長平坦度を一定に維持しながら波長多重信号光を 増幅する装置である。

【0016】次に、本発明による光増幅器の好適実施形 態の動作を、図1~図3を参照して詳細に説明する。先 ず、「調整段階」を説明する。入力光強度と、EDF温 度と、信号光の波長数情報と出力光の平坦度を最適にす る光アッテネータ6の制御(駆動)電圧との相関データ を「データテーブル」としてまとめる。

【0017】上述した「データテーブル」を外部メモリ 16に書き込む(ステップS1)。この外部メモリ16 には、電源が切れてもデータ保存が可能なメモリ(即 ち、不揮発性メモリ)を使用するのが好ましい。入力コ ネクタ1から信号光を入力する(ステップS2)と、光 カプラ2により光信号がN:Mに分岐される。この分岐 された光は、PD10に入力され、PD10により入力 光強度を対応する電流値に変換する(ステップS3)。 このときの電流値は、前段増幅器3に入力される光強度 を表している。PD10から出力された電流値は、IV 変換器15により、対応する電圧値に変換されて出力さ れる(ステップS6)。この電圧値が、AD変換器22 8は、それぞれ光ファイバ(図示せず)に接続される光 50 により対応するデジタル値に変換され、CPU11のメ 5

モリ11bに記憶される(ステップS7)。

【0018】EDF21の温度測定は、EDF21の設 置部の周辺温度をEDF温度としている。温度を検知手 段として、この例ではサーミスタ9を使用しており、こ のサーミスタ9により温度値に比例した電圧値が出力さ れる(ステップS4)。この電圧値は、AD変換器13 によりデジタル値に変換され、CPU11のメモリ11 b内に記憶される。外部メモリ16には、予め入力光強 度の電圧値とAD変換器13から出力されるデジタル値 との対応表を記憶させておく。また同様に、サーミスタ 9から出力される電圧値とEDF21の温度値の対応表 を外部メモリ16に記憶させておく。

【0019】次に、「動作状態」について説明する。C PU11は、PD10およびサーミスタ9の測定値およ びSV信号12を受け(ステップS5)、モニタ値が変 化しているか否か判定する(ステップS8)。モニタ値 が変化していない場合(ステップS8:NO)には、何 ら処理を行わず、後述するステップS15へ進む。-方、モニタ値が変化している場合(ステップS8:YE S) には、外部メモリ16から「データテーブル」を読 み出す(ステップS9)。そして、3種類のモニタ値が 「データテーブル」内にあるか否か判定する(ステップ S10)。「データテーブル」にない場合(ステップS 10: NO) には、上述したステップS8へ戻る。一 方、「データテーブル」内にある場合(ステップS1 0:YES)には、以下に説明するステップS11へ進 む。

【0020】そこで、CPU11は、3種類の情報と 「データテーブル」を比較し、適合するデジタル値を選 択する(ステップS11)。次に、CPU11は、「デ 30 ータテーブル」から選ばれたデジタル値を外部に出力す る(ステップS12)。デジタル値を、DA変換器14 によりアナログ電圧値に変換する(ステップS13)。 そして、このDA変換器14は、光アッテネータ6を駆 動して信号光の減衰量を変更する(ステップS14)。 最後に、後段増幅器7から出力コネクタ8を介して出力 される出力光の平坦度を一定に維持する(ステップS1 5) 。

#### [0021]

【発明の他の実施の形態】次に、本発明による光増幅器 の第2実施形態を説明する。基本構成は、上述した図1 および図2と同様である。しかし、上述した第1実施形 態におけるCPU11に光アッテネータ6の駆動量又は 制御信号を決定する「データテーブル」を与える代わり に、入力光強度、EDF温度および波長数情報の3種類 のパラメータを使用してアッテネータ駆動量を決定する 「計算式」を予めプログラミングしておく。CPU制御 部は、CPU11のメモリ11b内に記憶される3種類 のパラメータを、この「計算式」に代入する。そして、

ータテーブル」と同じ効果を得ることができる。図4 は、この動作を示すフローチャートである。

【0022】図4のフローチャートは、ステップS21 ~S36を含んでいる。ステップS21~S28は、図 3のステップS1~S8と同様であるので、説明は省略 する。次に、3種類にモニタ値が規定値内か否か判定す る(ステップS29)。規定値内でない場合(ステップ S29:NO) には、上述したステップS28に戻る。 一方、規定値内の場合(ステップS29:YES)に 10 は、メモリから「計算式」を読み出す(ステップS3 0)。この「計算式」に3種類の可変パラメータを代入 する(ステップS31)。次に、CPU11により光ア ッテネータ6の駆動量を計算する(ステップS32)。 計算結果をCPU11のメモリ11b内に記憶し、DA 変換器14に出力する(ステップS33)。そして、デ ジタル値をDA変換器14によりアナログ電圧値に変換 する(ステップS34)。光アッテネータ6を駆動し信 号光の減衰量を変更する(ステップS35)。最後に、 後段増幅器7を介して出力コネクタ8から出力される出 力光の平坦度が維持される(ステップS36)。「デー タテーブル」を用いた場合には、波長数が増加すると、 波長数分「データテーブル」数が増加してしまうので、 外部メモリの容量が増加してしまう。しかし、「計算 式」の場合には、波長数が増加しても「計算式」を変化 させるのみで良く、外部メモリ16の容量は増加しない という利点がある。

【0023】以下、本発明による光増幅器の好適実施形 態の構成および動作を詳述した。しかし、斯かる実施形 態は、本発明の単なる例示に過ぎず、何ら本発明を限定 するものではないことに留意されたい。本発明の要旨を 逸脱することなく、特定用途に応じて種々の変形変更が 可能であること、当業者には容易に理解できよう。

### [0024]

【発明の効果】以上の説明から明らかな如く、本発明の 光増幅器によると、次の如き実用上の顕著な効果が得ら れる。第1に、回路作成後のパラメータによるアッテネ ータ駆動量の変更が容易である。また、CPUによりア ラーム情報の管理等の様々な情報を管理し制御すること ができる。その理由は、全ての情報がデジタル化される ことにより、CPUにより増幅器全体の情報を集中管理 することが可能で、アッテネータ制御以外のCPU空き 時間を利用し、アラーム情報管理等もCPUにより制御 することが可能である。

【0025】第2に、CPUを使用することにより、ア ナログ回路では複雑になり、実装面積が大きくなる回路 でも、小型化することが可能である。その理由は、3種 類のモニタ値から光アッテネータの駆動電圧を定めてい るため、モニタ値が1種類の場合のように簡単なアナロ グ回路で作成することができず、回路規模が大きくなっ 光アッテネータ6の駆動量を算出することにより、「デ 50 てしまうのに対し、CPUにより光アッテネータの駆動 量を演算させることにより演算回路は不要となるため、 回路自体を単純化可能である。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光増幅器の好適実施形態の構成を 示すブロック図である。

【図2】図1に示す前段増幅器、中段増幅器および後段 増幅器内部の構成図である。

【図3】CPUによる3種類のモニタ値とデータテーブルの比較によりアッテネータ駆動量を得るフローチャートである。

【図4】CPUによる3種類のモニタ値と与えられた計算式からアッテネータ駆動量を得るフローチャートである。

【図5】温度等が変化した場合の、光アッテネータ制御前の出力光平坦度特性図の1例を示す図である。

【図6】温度等が変化した場合の、光アッテネータ制御 後の出力光平坦度特性図の1例を示す図である。 【符号の説明】

1、19入力コネクタ2、17光カプラ3、4、7増幅器5イコライザ6光アッテネータ

8、20 出力コネクタ

9 温度検出素子 (サーミスタ) 10 フォトダイオード (PD)

10 11 演算装置 (CPU)

12 波長数情報 (SV信号)

13、22 AD変換器 14 DA変換器

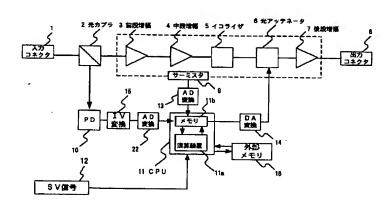
15 I V変換器

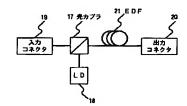
16 外部メモリ 18 レーザダイオード (LD)

21 EDF (エルビウムドープドファイバ)

【図1】

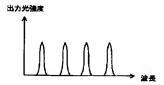
【図2】

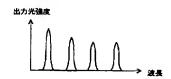




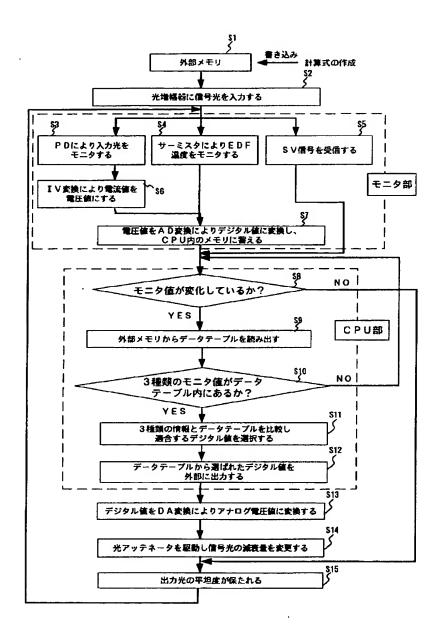
【図5】

【図6】





【図3】



【図4】

